

平成15年7月28日

委員 各位

日本学術振興会
「結晶加工と評価技術」第145委員会
委員長 梅野 正隆

日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会 第97回研究会

- (1) 日時 平成15年9月8(月)10:00 - 17:05
(2) 場所 東京都立大学 国際交流会館
(3) 東京都八王子市 TEL:0426-77-3001, FAX:0426-77-3002 京王線 南大沢 下車徒歩10分
<http://www.metro-u.ac.jp/campusmap/campusmap-j2.htm> (地図の中で14が国際会館)
(4) 研究会 テーマ「進展するSOI技術：現状と将来」

世話人 岸野正剛(姫路工大)、泉 勝俊 (大阪府大・先端研)

趣旨 今後のLSI産業の牽引車はこれまでのパソコンに変わって、これから広範囲に普及する携帯装置、更には自動車、ロボットになり、LSI製品の低消費電力化が益々重要になってくる。このような背景の下に今後のキーテクノロジーとしてSOI/LSIデバイス技術が注目されている。現在は、SOIデバイスの製造は今ひとつであるが、一部では量産が始まっており、今後、本格的な量産活動が期待される場所である。以上の背景の下に、本年も、第145委員会ではSOIウエーハ技術の現状と将来に視点を当てて研究会を開くことにした。テーマ項目として評価技術、デバイス技術、およびウエーハ技術を採り上げた。評価技術については現在最終年を迎えている(学振の)未来開拓研究プロジェクトの成果を、実用的評価技術に絞って数件講演して頂くことにした。デバイス技術については外国の招待講演者にも講演して頂く。また、ウエーハ技術については今回は海外からの招待講演1件に止めた。興味ある講演が期待頂けますので、多数の多彩な研究者のご参加をお願いしたい。そして、講演会での活発な討論が行われることを希望しています。なお、講演は一部を海外の招待講演者をお願いする関係もあり、英語講演もありますが、基本的には日本語中心に会議を運営いたします。

スケジュール

第I部 司会 岸野 正剛 (姫路工大院・工)

1. 10:00 10:05 開会の挨拶 梅野正隆 第145委員会委員長
2. 10:05 10:50 極低電力CMOS/FD-SOI回路技術の展望 門 勇一
(NTTマイクロシステムインテグレーション研究所 スマートデバイス研究部)
3. 10:50 11:35 重金属汚染SOIウエーハの電气的非接触マッピング評価
中村 成志、奥村 次徳 (都立大院・工)
4. 11:35 12:20 完全空乏ウエーハのC-V及びSCM電气的評価 吉田晴彦 (姫路工大院・工)

休憩 (12:20 13:10)

第II部 司会 泉 勝俊 (阪府大・先端研)

5. 13:10 14:10 SOI Device Scaling: From Single Gate to Multiple Gate Transistors
Anne Vandooren (APRDL, Motorola)
6. 14:10 14:55 PLによるSOIウエーハの物性評価及びマッピング評価 田島道夫(宇宙科学研)

休憩 (14:55 15:15)

第 III 部 司会 奥村 次徳 (都立大院・工)

- 7 . 15:15 16:00 市販 SOI 基板中欠陥の分布および構造解析 小椋 厚志、岡林 理(*)
NEC シリコンシステム研究所, (株) レーザテック
- 8 . 16:00 17:00 From Ultrathin SOI towards Strain Silicon on Insulator using the Smart Cut
Technology A. J. Auberton Herve (SOITEC)
- 9 . 17:00 17:05 閉会の挨拶 岸野 正剛 (姫路工大院・工)

懇親会 17:10 18:30 (会費 ¥2,000 円)

注: 学振委員以外の方のご出席も歓迎しますが、資料(予稿集)代として ¥1,000 円お支払い頂きます。